

(21) आवेदन सं. 9350/सीएचईएनपी/2013 ए

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(19) भारत

(22) आवेदन फाइल करने की तिथि: 21/11/2013

(43) प्रकाशन की तिथि: 24/06/2016

(54) खोज का शीर्षक: सिलिकॉन वीआईएस के माध्यम का उपयोग करते हुए एकीकृत परिपथ का डिज़ाइन

(51) अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण : H01L25/07, H01L25/065, H01L23/522

(71) आवेदक का नाम:

1) जिलिक्स इनकां.

आवेदक का पता : 2100 लॉजिक ड्राइव सैन जोस कैलिफोर्निया
95124 यू.एस.ए.

(31) प्राथमिक दस्तावेज़ सं. : 13/170020

(32) प्राथमिक तिथि : 27/06/2011

प्राथमिकता प्राप्त देश

(33) का नाम : यू.एस.ए. (अमेरिका).

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं

(86) फाइल करने की तिथि : PCT/US2012/021416
: 16/01/2012

(87) अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सं. : WO 2013/002844

(61) आवेदन सं. में जोड़

का पेटेंट

फाइल करने की तिथि : लागू नहीं

: लागू नहीं

आवेदन सं. में डिविज़नल

(62) फाइल करने की तिथि : लागू नहीं

: लागू नहीं

(72) खोजकर्ता का नाम :

1) रहमान अरीफ़र

(57) सारांश :

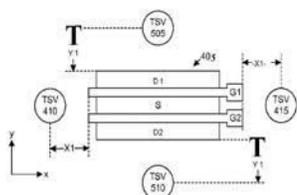


FIG. 5

एक एकीकृत परिपथ (आईसी) की संरचना में सिलिकॉन वीएसआईएस (TSVs) को विद्युत-परिपथ तंत्र के भौतिक विन्यास के रूप में लगाने का वर्णन किया गया है। आईसी संरचना में पहले विद्युत-परिपथ के तत्व की बहुलता (D1 G1 और S; 702 706 710 और 714; या 702 706 704 और 708); दूसरे परिपथ के तत्व (D2 G2 और S; 704 708 712 और 716; या 710 714 712 और 716) की बहुलता ; पहले TSVs (410 और 510; 605 620; या 720 734); और दूसरे TSVs (415 और 505; 625 640; या 736 750) की बहुलता हो सकती है। पहले और दूसरे परिपथ के तत्व और पहले और दूसरे TSVs मिलकर परिपथ के अवरोध के आकार को रोकते हैं। परिपथ का रुका आकार कम से कम एक अक्षांश की समरूपता से समरूप होता है। पहले TSVs के कम से कम एक TSV के बिना परिपथ की रुकावट का आकार समरूप नहीं हो सकता।

पृष्ठों की सं.: 40 दावों की सं.: 14